

トランジスタ

2SB970

# 2SB970

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

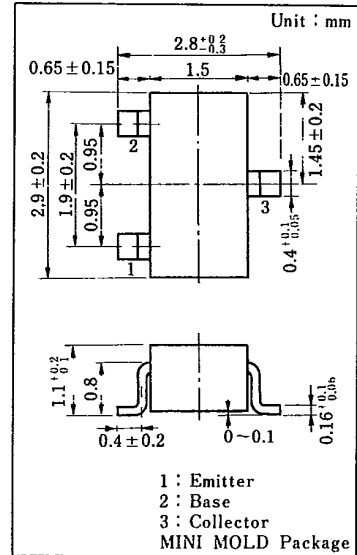
低電圧出力増幅用 / AF Output Amplifier

■ 特徴 / Feature

- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。 / Low  $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	15	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	10	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	7	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	1	A
コレクタ電流	$-I_C$	0.5	A
コレクタ損失	$P_C$	200	mW
接合部温度	$T_J$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0$			100	nA
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C = 10\ \mu\text{A}, I_E = 0$	15			V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 1\text{ mA}, I_E = 0$	10			V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E = 10\ \mu\text{A}, I_C = 0$	7			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}^{*1}$	$-V_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 0.5\text{ A}^{*2}$	100		350	
	$h_{FE2}$	$-V_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 1\text{ A}^{*2}$	60			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 0.4\text{ A}, -I_B = 8\text{ mA}$		0.16	0.3	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$-V_{BE(sat)}$	$-I_C = 0.4\text{ A}, -I_B = 8\text{ mA}$		0.8	1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 50\text{ mA}$		130		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		22		pF

\*2 パルス測定 / Pulse Test

\*1  $h_{FE1}$  ランク分類 /  $h_{FE1}$  Classifications

Class	Q	R	S
$h_{FE1}$	100 ~ 155	130 ~ 220	180 ~ 350
Marking symbol	1RQ	1RR	1RS

トランジスタ

T-29-15 2SB970

